Rivelatori a diamante

Cristina Tuvè

Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania & INFN, Catania e-mail: Cristina.Tuve@ct.infn.it

Proprietà del diamante
 Diamante come rivelatore di particelle
 Crescita diamanti CVD nel laboratorio di Roma Tor Vergata
 Caratterizzazione del diamante pCVD con tecniche nucleari

 modello a 2 fluidi
 Rivelatori a diamante monocristallini sCVD

 Applicazioni: monitor di fascio, dosimetri, rivelatori per SLHC

 Conclusioni

Struttura cristallina



- atomi di C su un reticolo tetraedrico classificato in cristallografia: cubico a facce centrate
- forti legami **sp³** (3.62 *eV*/legame)

Prof. Cristina Tuvè

Proprietà del diamante

Indice di rifrazione2.42 (a $\lambda = 550$ nm)Gemma10 (scala MoDurezza10 (scala MoConduttività termica20 W cm⁻¹ KTermostato

10 (scala Mohs)Lama20 W cm⁻¹ K⁻¹ (Tambiente: 5 volte Cu)

RESISTENZA AGLI AMBIENTI OSTILI

Bassa reattività chimica Elevata resistenza alle radiazioni Funzionamento ad alte temperature

monitor di fascio per acceleratori

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

PROPRIETA' ELETTRONICHE

Numero atomico Z	6
Lunghezza di radiazione X ₀	12 cm
Costante dielettrica	5.7
Energia per creare e-lacuna	13 eV
Gap	5.4 eV
Resistività	10¹⁶ Ω cm
Campo di breakdown	10 ⁷ V/cm
Mobilità di elettroni, lacune	
1800 , 1600 cm ²	² /V s
Velocità max degli elettr.	2.7 10 ⁷ cm/s

Proprietà		Diamante	Silicio
Numero Atomico Z		6	14
Peso Atomico A		12.01	28.09
Densità	[g cm ⁻³]	3.52	2.33
Numero di atomi	$[x10^{22} \text{ cm}^{-3}]$	17.7	4.96
Struttura cristallina		diamante	diamante
Costante reticolare	[Å]	3.57	5.43
Distanza fra primi vicini	[Å]	1.54	2.35
Energia di coesione U	[eV/atomo]	7.37	4.63
Compressibilità	$[x10^{11} m^2 N^{-1}]$	0.226	1.012
Funzione di lavoro φ	[eV]	4.81	4.58
Punto di fusione T _m	[°င]	~ 4100 *	1420
Conducibilità termica $\sigma_{\rm T}$	[W cm ⁻¹ K ⁻¹]	20	1.27
Coeff. Diff. per elettroni De	[cm ² s ⁻¹]	47	38
Coeff. Diff. per lacune D _h	[cm ² s ⁻¹]	31	13
Costante dielettrica z		5.70	11.9
Egap	[eV]	5.5	1.12
Energia per coppia elettrone-lac	una E _{pair} [eV]	13	3.6
Densità portatori intrinseci n _i	[cm ⁻³]	< 10 ³	1.5 x 10 ¹⁰
Resistività p _e	$[\Omega \mu_m]$	$> 10^{13}$	2.3 x10 ⁵
Mobilità elettroni µe	$[cm^2 V^{-1} s^{-1}]$	2400	1450
Mobilità lacune µ _n	$[cm^2 V^{-1} s^{-1}]$	2100	440
Tensione di rottura	[V cm ⁻¹]	107	3 x 10 ³
Modulo di Young	[GPa]	1134	131
Temperatura di fusione	[°C]	3350	1410
Campo di breakdown	[V/ µ m]	1000	30
Velocità di saturazione	[cm/s]	~ 10 ⁷	-
Lunghezza di radiazione	[cm]	12.03	9,4
Perdita per ionizzazione	[Mev/cm]	6.2	3.9
Num. Medio coppie/mip*100 μ	m	3600	9797
Num. Medio coppie/mip*300 μ	m	12938	29390

Proprietà fondamentali del diamante e del silicio a 300°k

Energia di legame alta minim. danno da rad. Mobilità: v = μE Elevata velocità di risposta Campo di breakdown: Elevato punto di rottura E Gap: 5.5 eV Basso rumore, bassa corrente di buio,operare a T elevate e con luce

Prof. Cristina Tuvè

Riassumendo...

Proprietà uniche:

- Resistenza alle radiazioni
- Lavoro in ambienti ostili
- Alta UV/visible discriminazione
- Veloce risposta in tempo
- Basso rumore bassa corrente di buio

Rivelatori di particelle

- Rivelatori di neutroni per reattori di fusione e fissione
- Dosimetri
- Sensori UV per osservazioni solari da satellite

A G OT LA

Diamanti naturali

.... tuttavia

Monocristallini ma di piccole dimensioni

Qualità elettroniche molto rare

Costosi, non c'è riproducibilità

Prof. Cristina Tuvè

Crescita del diamante



Diagramma delle fasi del carbonio.

Sintesi ad alta pressione ed alta temperatura (HPHT)

la crescita avviene nella regione del diagramma di fase del carbonio in cui il diamante è stabile

Diamanti sintetici HPHT

- Basso costo
- monocristallini
- Qualità elettronica scarsa

Sintesi a bassa pressione (CVD - Chemical Vapor Deposition)

Nel secondo il diamante viene cresciuto, a pressioni minori, nella regione in cui la grafite è stabile e il diamante metastabile

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Diagramma di fase



Diagramma di Bachmann. Diagramma ternario delle concentrazioni dei gas presenti nella camera di crescita.

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Processo di crescita

 il carbonio è fornito da gas contenenti C, O, H (H₂+ CH₄, CO₂+ CH₄)



 si depositano grafite (sp²) e diamante (sp³) su un supporto di silicio

 iniziano le fasi di nucleazione e crescita



 si rompono i legami della grafite e si creano centri per la formazione del diamante

Microwave Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (MPECVD)



Prof. Cristina Tuvè

MicroWave Plasma Enhanced Chemical Vapor **Deposition (MWPECVD)**



Parametri tipici di crescita

Composizione del Plasma H₂ / CH₄ 1% mix 750 °C Temperatura Potenza delle Microonde 650 W Pressione 120 mbar Flusso dei gas 100 sccm

Substrato:

(100) Si monocristallino (103MΩ) scratching

I diamanti sono costruiti nel Laboratorio dell'Università di Roma Tor Vergata

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Produzione dei film di diamante CVD policristallini



Sezione di un film di diamante policristallino visto al microscopio elettronico a scansione (SEM). Sono evidenti la struttura multicolonnare e, in basso, il substrato di silicio su cui viene fatto crescere il diamante.



Lato di crescita di un campione di diamante con relativa scala delle distanze.

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Caratterizzazione Raman



Spettri PL di film di diamante CVD cresciuti in differenti condizioni

- a) CH_4 - CO_2 miscela gassosa, CH_4 =50.0%
- b) CH_4 - CO_2 miscela gassosa, CH_4 =47.4%
- c) CH_4 - H_2 miscela gassosa, CH_4 =0.6% Dopo l'ottimizzazione del reattore di crescita
- FWHM = 2.4 cm⁻¹ Larghezza del picco Raman confrontabile con quello del diamante naturale monocristallino (FWHM=2cm⁻¹)
- ✓ Assenza di fase non-diamante a ~ 1500 cm⁻¹
 ✓ Banda PL estremamente debole (A_{Pl}/A_D<1/60)

G. Messina - Università di Reggio Calabria

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Generazione della carica



- diamante 13 eV
- silicio 3.6 eV



- l'energia rilasciata da particelle cariche promuove elettroni dalla banda di valenza a quella di conduzione
- a differenza del silicio, il diamante ha un valore di energia necessario alla creazione di una coppia (e⁻ - h) molto elevato

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Rivelatore a Diamante





Contatto Au Superficie 7 mm² Diametro 2.5mm spessore 100 nm contatto Ag pittura

- Q_c : carica indotta per ciascuna coppia e-h
 - D : spessore del rivelatore
 - e : carica dei portatori
 - x : distanza totale percorsa da e h

>Charge Collection Distance (CCD):

 $\delta = \lambda_e + \lambda_h = (\mu_e \tau_e + \mu_h \tau_h) \mathbf{E}$

- λ_e , λ_h : libero cammino medio per elettroni e lacune μ_e , μ_h : mobilità di elettroni e lacune
- τ_e , τ_h : tempo di vita medio per lacune ed elettroni
- E: campo elettrico applicato

Prof. Cristina Tuvè

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009



Efficienza
 η = Qc/Q0
 Qc: carica rivelata
 Q0: carica totale

CCD - Efficienza

Il legame tra $\eta \in \delta$ si può dedurre dalla teoria di Hecht ^(*):

Dalla teoria di Hecht, supponendo un film omogeneo ed essendo G la profondità di penetrazione della particella ionizzante, :

$$\eta = \frac{\delta}{D} \left[1 - \frac{\delta}{4G} \left(1 - e^{-\frac{2G}{\delta}} \right) \left(1 + e^{-\frac{2(G-D)}{\delta}} \right) \right]$$

G: profondità di penetrazione della particella ionizzante; D: spessore del rivelatore. Si assume: E uniforme, $\lambda_e = \lambda_h$ e una distribuzione di ionizzazione u(x) = costante. Gi tatazzione di contenti di conte

Per avere una alta efficienza occorre che la distanza di raccolta delle cariche sia alta. Quindi una misura di efficienza si può mettere in relazione ai difetti presenti all'interno del campione

Campioni che mostano uno stretto picco Raman e un fondo di fotoluminescenza basso possono presentare un diverso comportamento quando essi vengono utilizzati come rivelatori di particelle

La rivelazione di particelle può essere usata come una sonda per caratterizzare i difetti presenti nel cristallo.

^(*) K.Hecht, Z.Phys 77, 235(1932)

Prof. Cristina Tuvè

pumping

Effetto ottenuto tramite pre-irraggiamento con particelle β

Particelle α di 5.5 MeV emesse da una sorgente di ²⁴¹Am; film d= 100 μ m ; V= 100 volt • < η > = 47 % • G = 15 μ m

250 Aumento dell'efficienza e della CCD 200 Cambiamento nella forma del Counts 150 picco 10 20 30 L'effetto è stabile per mesi 100 se il campione è mantenuto 50 al buio Risoluzione in energia >50% 0 20 40 60 80 0 η (%)

Marinelli et al. Applied Physics Letters 75 (1999) 3216

Effetto della polarità



As-grown: il comportamento del rivelatore non dipende dalla polarizzazione

Pumping: per polarità negativa non si nota nessun cambiamento del segnale in quanto all'impulso contribuiscono quasi esclusivamente le lacune che vanno verso l'elettrodo negativo. Per polarità è positiva poiché si saturano i difetti deep-centers (trappole per le lacune) aumenta δ (lacune viaggiano per più tempo indisturbate) aumenta, quindi l'ampiezza del segnale.

> Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009



Set-up sperimentale LNS



Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

All'acceleratore Cockcroft-Walton	LNS	
e Astronomia di Catania	Diffusore Au:286µg/cm²Fascio:6Li e 12C	
Diffusore Au:104µg/cm²Fascio:Protoni e AlfaEnergia Protoni:(0.4 ÷ 2.0) MeVEnergia Alfa:(0.8 ÷ 6.0) MeVPenetrazione Protoni:(2.1 ÷ 24.4) µmDecempenatione Alfa:(1.4 ÷ 415.6) µm	Energia ⁶ Li: $(6.5 \div 47.4)$ MeV Energia ¹² C: $(16.2 \div 92.2)$ MeV Penetrazione ⁶ Li: $(7.2 \div 171)\mu m$ Penetrazione ¹² C: $(7.5 \div 87.4)\mu m$ Energia depositata ⁶ Li: $(6.5 \div 19.1)$ MeV Energia depositata ¹² C: (16.1 ± 55.6) MeV	
Penetrazione Alfa: $(1.4 \div 15.6) \mu m$ Energia depositata Protoni: $(0.4 \div 2.0) MeV$ Energia depositata Alfa: $(0.8 \div 6.0) MeV$ Densità di energia di ionizzazione Protoni: $(8.7 \times 10^{-2}) MeV/\mu m$	Energia depositată ¹² C: (16.1 ÷ 55.6)MeV Densità di energia di ionizzazione ⁶ Li: 0.69MeV/µm Densità di energia di ionizzazione ¹² C: 1.94MeV/µm	
Densità di energia di ionizzazione Alfa: 0.4MeV/μm Sia i protoni che le alfa perdono tutta la loro energia all'interno dei campioni (D1 da E0μm o SCD21 da 4Eμm), la profondità	E _{inc} > 55 MeV : ¹² C perde solo parte dell'energia e la profondità di penetrazione è lo spessore del rivelatore; ioni fortemente penetranti permettono di effettuare uno <u>scanning</u> completo in penetrazione dei campioni e, quindi, di capire la differenza di risposta del rivelatore al variare di G	

E_{inc}< 55 MeV : ¹²C perde tutta l'energia e la profondità di penetrazione va da 10.5 µm allo spessore del rivelatore

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Prof. Cristina Tuvè

24.4µm.

di penetrazione va da 1.4µm fino ai

Risultati sperimentali (LNS)



Efficienza

distribuzione uniforme dei difetti ==> u(x) = constante da 0 a G

$$\eta = \frac{\delta}{D} \left[1 - \frac{\delta}{4G} \left(1 - e^{-\frac{2G}{\delta}} \right) \left(1 + e^{-\frac{2(G-D)}{\delta}} \right) \right]$$

Se si considerano differenti liberi cammini medi λ_e and λ_h per elettroni e lacune

elettroni

lacune

$$L_{e} = \lambda_{e} \left[1 - \frac{\lambda_{e}}{G} \left(1 - exp \frac{-G}{\lambda_{e}} \right) \right]$$

$$L_{h} = \lambda_{h} \left[1 - \frac{\lambda_{h}}{G} \left(exp \frac{G - D}{\lambda_{h}} - exp \frac{-D}{\lambda_{h}} \right) \right]$$
• Efficienza:
Prof. Cristina Tuvè

1. Se la profondità di penetrazione è piccola: $\rightarrow 0$ $\left(\alpha \text{-particle e}^{12} \text{C di bassa energia} \right)$ Polarizzazione positiva $\eta = \frac{\lambda_h}{D} \left| 1 - exp \right| - \frac{D}{\lambda}$ $\eta^- < \eta^+$ **Polarizzazione negativa** $\eta = \frac{\lambda_e}{D} \left| 1 - exp - \frac{D}{\lambda} \right|$ 2. Se il fascio non si ferma nel rivelatore: (¹²C di alta energia) $\eta = \frac{\lambda_e + \lambda_h}{D} - \frac{\lambda_e^2 \left[1 - \exp\left(\frac{-D}{\lambda_e}\right) + \lambda_h^2 \left[1 - \exp\left(\frac{D}{\lambda_h}\right)\right]}{D}\right]}{D^2}$

R. Potenza, C. Tuvè, *Measurements of defect density inside CVD diamond films through nuclear particle penetration,* in "Carbon: the Future Material for Advanced Technology Applications", Springer Series Topics in Applied Physics, 2005, pag.267

Prof. Cristina Tuvè

Modello per la distribuzione dei difetti



Difetti in grano: supposti uniformemente distribuiti nel campione Bordi di grano: concentrati sul lato del substrato (distribuzione esponenziale (*))

 $W_e(x) + W_h(x) = O(x)$ Distanza di raccolta *dipendente da x*

Prof. Cristina Tuvè

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

(*) Appl. Phys. Lett. <u>75(1999)3216</u>

Curva teorica

penetration depth (µm)



La convoluzione della $\eta(x,y,z)$ locale con la produzione di densità di carica (curva di Bragg) ci dà l'efficienza di raccolta carica media per la particella.

$$w_{h,e}(x) = a_{h,e} + be^{(x-D)/d}$$

 $1/a_e = 0.3 \ \mu m; \ 1/a_h = 13 \ \mu m$ b = 3 \ \mu m^{-1}; c = 8 \ \mu m

δ(0) / δ(D/2) = 0.1 δ(D/2) / δ(D) = 0.6 Difetti concentrati sul lato del substarto (c=8µm)
 Soluzione miglore: diamanti CVD omoepitassiali su substrati HPHT di basso costo

> Scuola Nazionale INFN C. Tuvè et al, Diamond and Related Material 12(2002)499 C. Tuvè et al, Bormio Proceedings 2003

Monitor di fascio: confronto diamante-Faraday cup

I diamanti pCVD sono stati usati al LNS per monitorare il fascio accelerato che incide direttamente sul campione di diamante. Il fascio di p (26MeV) ha 10¹⁰ ioni/s.cm², cioè ha una fluenza di circa 10¹⁴ p/cm²/h. Il diamante è stato esposto al fascio diretto per 3 giorni per una fluenza totale di circa 5.10¹⁵ p/cm2.



 Risposta del diamante più sensibile di quella della Faraday cup (fluttuazioni più grandi nel segnale di uscita della faraday cup: sono rivelati molto meno elettroni)
 Velocità di risposta (in questa scala) come Faraday cup

> Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Crescita di diamanti monocristallino

Diamanti policristallini CVD

 ✓ Grande area di deposizione
 ✓ Campioni molto difettosi
 ✓ Effetti di polarizzazione e di memoria

✓ Scarsa stabilità e riproducibilià
✓ Lenta risposta temporale

Substrati

(100) orientati HPHT Ib-type (Elemient 6)

Parametri tipici di crescita

Composizione del pla	asma 99% H_2 - 1% CH ₄
Temperatura	650 – 800 °C
Microwave power	500 - 700 W
Pressione	100 – 150 mbar
Gas flow rate	40 – 100 sccm



Prof. Cristina Tuvè

Produzione dei film di diamante CVD monocristallini



Sezione di un film di diamante monocristallino su substrato di diamante naturale visto al SEM.

Prof. Cristina Tuvè

caratterizzazione 1

Raman-PL spectroscopy ⇒ buona qualità del film di diamante



Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Rivelatore sCVD

Configurato in una sruttura p-type /intrinsic /Schottky-metal





Caratterizzazione spettroscopica

Tripla sorgente α ²³⁹Pu \rightarrow 5.16 MeV

 $^{241}\text{Am} \rightarrow 5.48 \text{ MeV}$

²⁴⁴Cm → 5.80 MeV



- ✓ 100% efficienza di raccolta delle cariche
- ✓ 100% efficienza di rivelazione
- ✓ risoluzione in energia 0.5-1.8 %
- ✓ No effetto di pompaggio
- Stabilità a lungo termine (no effetti di polarizzazioni)
- Riproducibilità
 Prof. Cristina Tuvè



Set-up sperimentale al LNS





VIM (variable incidence method)

L'angolo della particella incidente è stata variata nell'intervallo 0° ÷ 90° allo scopo di cambiare la profondità di penetrazione delle particelle incidenti

- Efficienza di rivelazione
- Risoluzione in energia vs. Profondità di penetrazione
- Stabilità della risposta

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Rotating holder lon n Beam Sample



Protoni (LNS)

Spessore dello strato attivo: 55 µm (« p_d (protoni) @ 0° incidence)







- Sector Energia rivelata E_c aumenta con θ.
- A un angolo di incidenza più grande di un θ* le particelle rilasciano tutta la loro energia E_c rivelata satura a un valore che corrisponde al valore massimo della η.

All'aumentare di θ diminuisce la profondità di penetrazione lungo la direzione del campo elettrico e ciò corrisponderebbe ad avere energie del fascio incidente sempre più piccole.

10, 15, 23 MeV ⁶Li

SCD #3 spessore 55 µm, V_{BIAS} = 75 V



Rivelatori a diamante per un Super tracciatore per SLHC

"Upgrade" dell'acceleratore LHC verso Super-LHC (SLHC) (2015) al CERN porterà ad aumentare di 10 volte la luminosità: 10³⁵ cm⁻² s⁻¹.

Sarà una sfida nella costruzione dei rivelatori di traccia (tracciatori) degli esperimenti che si progetteranno.

Ci sarà un livello di radiazione molto elevato, una grande densità di tracce così come un ridotto "bunch crossing time" dell'ordine di 10 ns. La regione più critica in termini di ambiente ostile è quella che è attualmente coperta dai rivelatori a silicio a pixel che si trovano a un raggio tra 4 e 11 cm dalla linea di fascio. La fluenza integrata sull'intero tempo di run di SLHC è nell'intervallo da 10¹⁶ a 10¹⁵ n_eq/cm².

La sfida più grande è per i rivelatori che costituiranno i tracciatori

sensori con ottima resistenza alle radiazioni

Buono S/N.

RIVELATORI A DIAMANTE

Prof. Cristina Tuvè

The 2009 RD42 Collaboration

D. Asner²², M. Barbero¹, V. Bellini², V. Belyaev¹⁵ E. Berdermann⁸, P. Bergonzo¹⁴, J-M. Brom¹⁰, M. Bruzzi^a, V. Cindro¹², G. Claus¹⁰, M. Cristinziani¹ S. Costa², R. D'Alessandro⁶, W. de Boer¹³, D. Dobos³ Dolenc¹², W. Dulinski¹⁰, V. Eremin⁹, R. Eusebi⁷ F. Fizzotti¹⁸, H. Frais-Kölbl⁴, A. Furgeri¹³, K.K. Gan¹⁶ M. Goffe¹⁰, J. Goldstein²¹, A. Golubev¹¹, A. Gorišek¹² E. Griesmayer⁴, E. Grigoriev¹¹, D. Hits¹⁷, F. Hügging¹ H. Kagan^{16,0}, R. Kass¹⁶, G. Kramberger¹² S. Kuleshov¹¹, S. Lagomarsino⁶, A. La Rosa³, A. Lo Giudice¹⁸, I. Mandic¹², C. Manfredotti¹⁸, C. Manfredotti¹⁸, A. Martemyanov¹¹, M. Mathes¹, D. Menichelli^s, S. Miglio^s, M. Mikuž¹², M. Mishina⁷, J. Moss¹⁶, S. Mueller¹³, G. Oakham²², P. Olivero¹⁸, G. Parrini⁶, H. Pernegger³, M. Pomorski¹4, R. Potenza², S. Roe³, M. Scaringella⁵, D. Schaffner²⁰ C. Schmidt⁸, S. Schnetzer¹⁷, T. Schreiner⁴, S. Sciortino⁶, S. Smith¹⁶, R. Stone¹⁷, C. Sutera², M. Traeger⁸, D. Tromson¹⁴, W. Trischuk¹⁹, J-W. Tsung¹, C. Tuve², J. Velthuis²¹, E. Vittone¹⁸, R. Wallny²⁰, P. Weilhammer^{3,0}, N. Wermes¹

Spoke spersons

75 Participants

¹ Universität Bonn, Bonn, Germany ² INFN/University of Catania, Catania, Italy ³ CERN, Geneva, Switzerland ⁴ Fachhochschule f
ür Wirtschaft und Teichnik, Wiener Neustadt Austria INFN/University of Florence, Florence, Italy. ⁶ Department of Energetics/INFN, Florence, Italy ⁷ FNAL, Batavia, U.S.A. ⁸ GSI, Darmstadt, Germany ⁹ loffe Institute, St. Petersburg, Russia ¹⁰ IPHC, Strasbourg, France ¹¹ ITEP, Moscow, Russia ¹² Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia. 13 Universität Karlsruhe, Karlsruhe, Germany 14 CEA-LIST Technologies Avancees, Saclay, France ¹⁵ MEPHI Institute, Moscow, Russia ¹⁶ The Ohio State University, Columbus, OH, U.S.A. ¹⁷ Rutgers University, Piscataway, NJ, U.S.A. 18 University of Torino, Torino, Italy ¹⁹ University of Toronto, Toronto, ON, Canada.

22 Institutes

2

Prof. Cristina Tuvè

2008 LHCC Milestones

Priorities of Research in 2008 (LHCC 2008-005)

- Test the radiation hardness of the highest quality pCVD and scCVD diamond.
- Develop diamond pixel modules useful at the LHC.Industrialization of the process.
- Beam tests with diamond pixel trackers and pixel detectors.
- Continue the development of pCVD and scCVD diamond material. Develop additional suppliers.
- Continue the development of systems for beam monitoring for the LHC.

These points were addressed in the talk.

Proposed RD42 Research in 2009

- Radiation Hardness of Diamond Trackers and Pixel Detectors
 - Continue tracker and pixel irradiations in the next year,
 - Use pCVD and scCVD
- Pixel Detector Modules
 - Test Industrial Modules (IZM)
 - Construct two additional modules funded by ATLAS R&D?.
- Beam Tests with Diamond Trackers and Pixel Detectors
 - Complete test of ATLAS diamond pixel modules
 - Irradiation of one ATLAS diamond pixel module
- Diamond Characterization
 - Continue research program to improve material in progress:
 - \circ collection distance \rightarrow 325 μ m ($\bar{Q} = 11,700e$)
 - $\circ \to \text{ improved uniformity}$
 - → identification of trapping centers
 - compare scCVD with pCVD

These points should be addressed in this meeting.

Prof. Cristina Tuvè

Introduction

Tracking Devices Close to Interaction Region of Experiments

 \rightarrow Inner tracking layers must provide high precision tracking (to tag b, t, Higgs, ...)

 \rightarrow Inner tracking layers must survive! \rightarrow what does one do? annual replacement?



Look for a Material with Certain Properties:

- Radiation hardness (no frequent replacements)
- Low leakage current, low dielectric constant → low readout noise
- ◆ Room temperature operation, Fast signal collection time → no cooling

RD42 CERN Meeting Dec. 14, 2006

RD42 Diamond Overview (page 2)

Harris Kagan Ohio State University

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Highlights of RD42 Presentation

Material Status



Recent pCVD wafers ready for test - Cr/Au dots are 1 cm apart

- New wafers continually being produced.
- Contract for material with ccd > 275μm.

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Prof. Cristina Tuvè

6

Rivelatori Pixel





Prof. Cristina Tuvè

Danneggiamento da radiazione

pCVD and sCVD seguono la stessa curva di danneggiamento: 1/ccd=1/ccd0 + k .



Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

DOSIMETRI

PROPRIETA' "DOSIMETRICHE" diamante

- Tessuto equivalente
 Alta risoluzione spaziale
 Esistenza alle radiazioni
- Dosimetri fatti di diamante naturale sono già sul mercato (PTW – Freiburg) IAEA certified
- ✓ *Diamanti* naturali (DDN):
 - Le pietre sono diverse l'una dall'altra
 - > (1 DDN buono per 4000 !)
 - > Alto costo (~15 k€)
 - > Tempi di consegna di circa 1 anno

Richieste stringenti:

- Stabilità
- Veloce risposta in tempo
- Linearità con la dose
- Confrontabile con le camere a ionizzazione
- Indipendenza dall'energia
- Indipendenza dal dose rate
- Riproducibilità



Applicazioni in radioterapia e prototerapia

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

sCVD Dosimetri "Roma Tor Vergata"



Synthetic Single Crystal CVD Diamond (SSCD)
 Tessuto equivalente e impermiabile all'acqua
 Non è applicata nessuna tensione di alimentazione (V_b=0 V)

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009





I-V curve under 10 MV bremsstrahlung X- ray irradiation dose rate: 3 Gy/min



20

30

40

50

Non c'è d.d.p. applicata

Ciò è di grande importanza quando si fà dosimetria in vivo Scuola Nazionale INFN

Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

The San Filippo Neri Hospital facility, Rome (Italy)

Experimental setup:

Acceleratore: Varian DHX
 Fantoccio ad acqua (PTW)
 Tandem electrometer (PTW)



Fasci- X di Bremsstrahlung con E_{max} = 6 and 10 MeV Fasci di elettroni: ; E = 6 ÷18 MeV

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009





Dopo una pre-irradiazione, il segnale è stabile all"1%

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Linearità: con la dose



Dose rate: 3 Gy/min Dose: 0.04 ÷ 50 Gy

Comportamento lineare

Indice di linearità $\Delta \sim 1$ (y = a·x^{Δ})

Deviazioni dalla linearità minori di 0.5%

Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Linearità: dipendenza dalla dose



Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Dipendenza dal Dose rate: fotoni

- The Dose Rate was evaluated by changing the accelerator pulse repetition frequency (PRF) or varying the source to surface distance (SSD).
- A very wide range was investigated: from 40 Gy/min down to 0.029 Gy/min
- In all cases a linear behavior was observed, with 0.98<c<1.04
- This is NOT observed in NDD. They need a software correction factor to take into account this problem



Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009



Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Stabilità: protoni 60 MeV



Scuola Nazionale INFN Legnaro (PD) 21 Aprile 2009

Conclusioni

Il diamante è un materiale che presenta notevoli proprietà da un punto di vista meccanico, ottico ed elettronico. Presenta anche delle ottime qualità per essere usato come dosimetro.

E' resistente al danno da radiazione.

Molti sforzi si sono fatti negli anni per migliorare la qualità dei film di diamanti.

Rivelatori pCVD presentano difetti che limitano sia l'efficienza di raccolta cariche che la risoluzione in energia. Essi possono essere utilizzati come monitor di fascio o come rivelatori in un tracciatore (dove viene richiesto un buon Signal/Noise e una resistenza al danno da radiazioni ma non una elevata risoluzione energetica)

Rivelatori sCVD presentano una buona riproducibilità, un' efficienza di raccolta carica del 100% e una risoluzione in energia che li rendono confrontabili con il silicio. Ottimi per spettroscopia e ottimi come dosimetri.

Prof. Cristina Tuvè